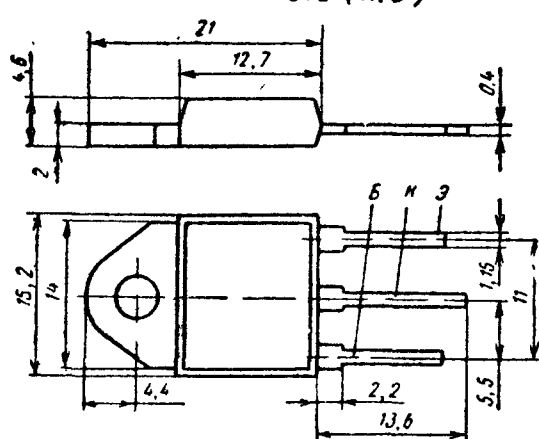


КТ872 (А, Б)

КТ872 (А, Б)



Транзисторы кремниевые ме-
запланарные структуры *n-p-n* им-
пульсные. Предназначены для
применения в оконечных каскадах
строчной развертки цветных теле-
визоров. Корпус пластмассовый с
жесткими выводами.

Масса транзистора не бо-
лее 20 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K=0,1$ А, $L=40$ мГн, не менее	700 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=$ $=4,5$ А, $I_B=2$ А:	
$T_K=+25^\circ\text{C}$:	
КТ872А	0,3..1 В
КТ872Б, не более	5 В
$T_K=-25$ и $+125^\circ\text{C}$:	
КТ872А, не более	2,5 В
КТ872Б, не более	6 В
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ}==5$ В, $I_K=0,2$ А, типовое значение	7* МГц
Время спада при $U_{КЭ}=500$ В, $I_K=4,5$ А, $I_B=1,4$ А, $U_{БЭ,отн}=-5$ В, не более	1 мкс
типичное значение	0,7* мкс
Время рассасывания при $U_{КЭ}=500$ В, $I_K=4,5$ А, $I_B=1,4$ А, $U_{БЭ,отн}=-5$ В, не более	7,5 мкс
типичное значение	6,5* мкс
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{КЭ,и,макс}==1500$ В, $U_{БЭ}=0$, не более:	
$T_K=+25^\circ\text{C}$	1 мА
$T_K=-25$ и $+125^\circ\text{C}$	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=6$ В, не более	10 мА
Ток вторичного пробоя при $U_{КЭ}=120$ В, $t_u=200$ мкс, не менее	11 А
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}=15$ В, $f=1$ МГц, типичное значение	125* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер	700 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при $U_{ЭБ}=0$	1500 В
Постоянный ток коллектора	8 А
Импульсный ток коллектора	15 А
Постоянный ток базы	4 А
Импульсный ток базы	6 А
Постоянный запирающий ток базы	100 мА
Импульсный запирающий ток базы	5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_K==-25...+25^\circ\text{C}$	100 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	150 °С
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}..T_K==+125^\circ\text{C}$

¹ При $T_K > +25^\circ\text{C}$ $P_{K,макс}$ определяется по формуле
 $P_{K,макс} \text{ Вт} = (150 - T_K) / R_{T(n-p)}$

где $R_{T(n-p)}$ определяется из области максимальных режимов.

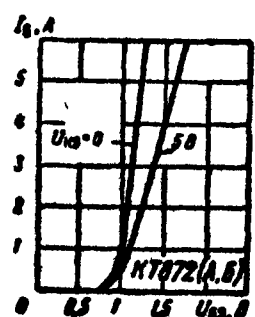
Допускается одновременная формовка выводов транзисторов не ближе
5 мм от корпуса. Радиус изгиба не менее 1 мм. Оснастка для формовки вы-
водов должна иметь защитное заземление.

При отсутствии контроля температуры корпуса пайка выводов допускает-
ся не ближе 5 мм от корпуса при температуре не более $+265^\circ\text{C}$ в течение не
более 3 с; при контроле температуры корпуса $+125^\circ\text{C}$ пайка допускается при
температуре не более $+280^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с. Время лужения 2 с. При
проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек выводов.

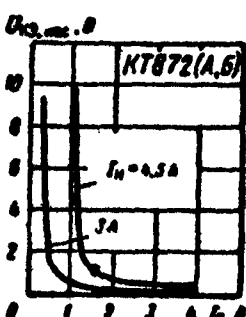
Допускается применять транзисторы в совмещенных блоках строчной раз-
вертки и электропитания; при этом частота переключения не более 16 кГц.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

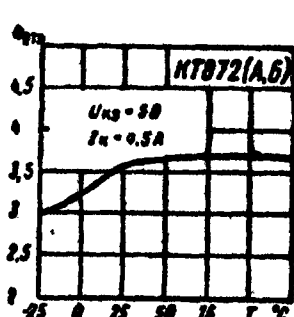
При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность само-
возбуждения транзисторов за счет паразитных связей.



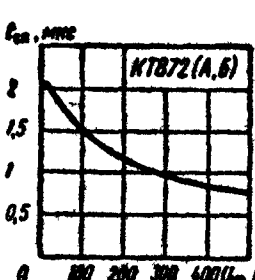
Входные характеристики



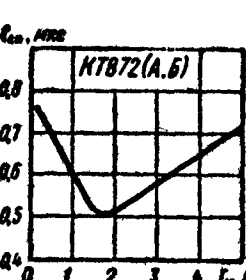
Зависимости напряже-
ния насыщения коллек-
тор — эмиттер от тока
базы



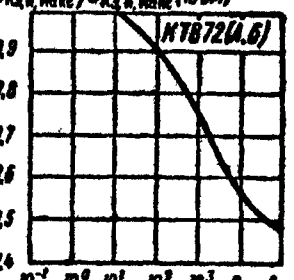
Зависимость статическо-
го коэффициента пере-
дачи тока от темпера-
туры корпуса



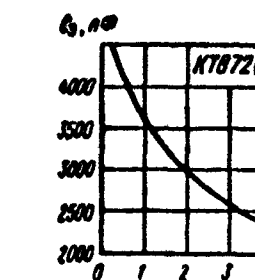
Зависимость времени
спада от напряжения
коллектор — эмиттер



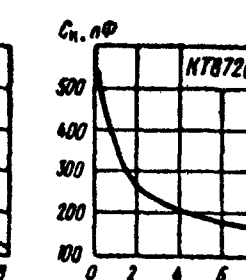
Зависимость времени
спада от тока коллек-
тора



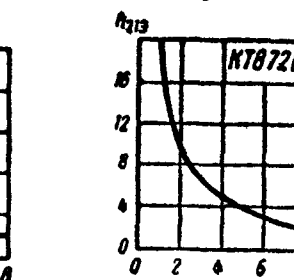
Зависимость максимал-
но допустимого им-
пульсного напряжения
коллектор — эмиттер от
сопротивления база —
эмиттер



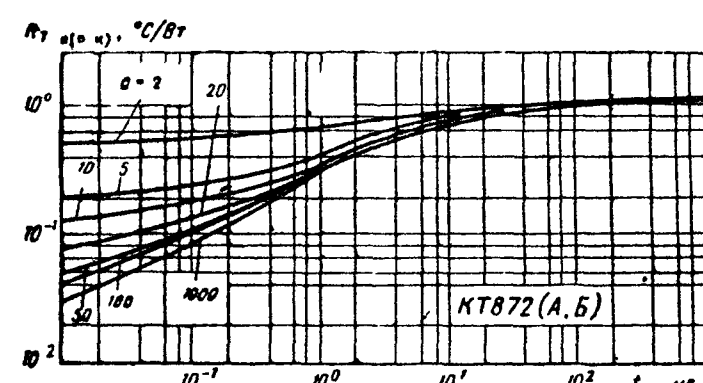
Зависимость емкости
эмиттерного перехода от
напряжения база —
эмиттер



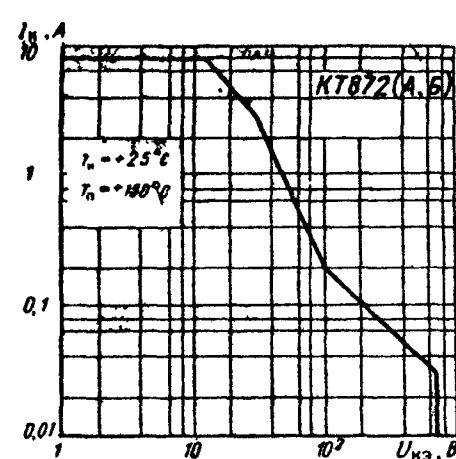
Зависимость емкости
коллекторного перехода
от напряжения коллек-
тор — база



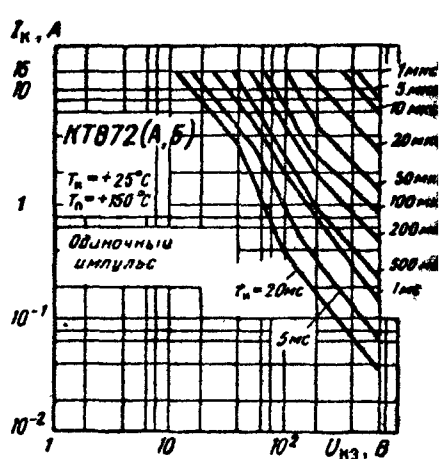
Зависимость статическо-
го коэффициента пере-
дачи тока от тока кол-
лектора



Зависимость им-
пульсного теплового
сопротивления пере-
ход — корпус от дли-
тельности импульса



Область максимальных режимов



Область максимальных режимов